




| | |
|---|--|
|  | <h2>DMN6013LFGQ-13</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: DMN6013LFGQ-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET NCH 60V 10.3A POWERDI</p> <p>Datenblätter:  DMN6013LFGQ-13.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |


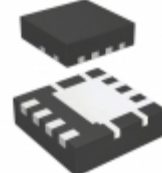

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMN6013LFGQ-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET NCH 60V 10.3A POWERDI |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerDI3333-8 |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 10A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 1W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2577pF @ 30V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 55.4nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 10.3A (Ta), 45A (Tc) |

DMN6013LFGQ-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN6013LFGQ-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN6013LFGQ-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN6013LFGQ-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>DMN5L06WKQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V SOT323</p> |  <p>DMN5L06WK-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 50V 300MA SC70-3</p> |  <p>DMN6013LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 10.3A PWDI3333-8</p> |  <p>DMN601DWK 109K DMN601DWK 109K</p> |
|  <p>DMN6013LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 10.3A PWDI3333-8</p> |  <p>DMN601DMK-7-F DIODES DIODES SOT23-6</p> |  <p>DMN600V-7 DIODES DMN600V-7 DIODES</p> |  <p>DMN6017SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 60V 43A TO252</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| DMN6013LFGQ-13 Diodes Incorporated | DMN6013LFGQ-13 Datenblatt | DMN6013LFGQ-13-Datenblätter | DMN6013LFGQ-13 PDF | Diodes Incorporated DMN6013LFGQ-13 |
| DMN6013LFGQ-13 Electronic | DMN6013LFGQ-13-Komponenten | DMN6013LFGQ-13-Verteiler | DMN6013LFGQ-13-Bild | DMN6013LFGQ-13-Teil |
| DMN6013LFGQ-13 Preis | DMN6013LFGQ-13 Hersteller | DMN6013LFGQ-13 Bild | DMN6013LFGQ-13 Aktie | DMN6013LFGQ-13 Inventar |
| DMN6013LFGQ-13 Neu | DMN6013LFGQ-13 Original | DMN6013LFGQ-13 garantiert | DMN6013LFGQ-13 RFQ | DMN6013LFGQ-13 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited